

MOS Metal-Oxide-Semiconductor

Formado por sustrato de silicio dopado, forma los transistores MOSFET, puede almacenar la carga correspondiente a los bits de las memorias dinámicas, se usan como condensadores de precisión.

CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor

Bajo consumo de potencia estática, robustos frente a ruido o degradación de señal, llegan a ser lentos.

BICMOS

Combinación de bipolar y CMOS, baja capacitancia, alto ancho de banda, alta velocidad, alto coste, pueden explotar.